

НОВОСЯДЛИЙ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

доктор технічних наук

2016

1. **Новосядлий С. П.** Діагностика субмікронних структур ВІС / С. П. Новосядлий, А. І. Терлецький. – Івано-Франківськ : СІМІК, 2016. – 480 с.

2015

2. **Новосядлий С. П.** Варізонна технологія формування структур швидкодіючих GaAs - транзисторів як основи сучасних ВІС / С. П. Новосядлий, А. М. Босацький // Фізика і хімія твердого тіла. – Івано-Франківськ, 2015. – Т. 16, № 1. – С. 221–229.

3. **Новосядлий С. П.** Високоєфективні структури ФЕП : моногр. / С. П. Новосядлий. – Івано-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника", 2015. – 370 с.

4. **Новосядлий С. П.** Комп'ютерне моделювання арсенід галієвих супер бета-транзисторів на гетероструктурах для швидкодіючих ВІС / С. П. Новосядлий, В. С. Гузік // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – № 3. – С. 599–605.

5. Пат. Спосіб іонно-плазмового формування планарного дифузійного джерела із нітриду бору. № 108820, 10.06.2015р. / **Новосядлий С. П.**, Мельник Л. В., Новосядлий С. В., Бережанський В. М / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» ; заяв. 10.06.2015.

6. Розробка технології багатозарядної іонної імплантації GaAs для субмікронних структур великих інтегральних схем / **Новосядлий С.П.**, Бойко С.І., Мельник Л.В., Новосядлий С.В. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – Т.5, № 12. – 8 с.

7. **Новосядлий С. П.** Сучасні проблеми САПР топології структур ВІС : моногр. / С. П. Новосядлий, Л. В. Мельник. – Івано-Франківськ : СІМІК, 2015. – 228 с.

8. **Новосядлий С. П.** Формування КМОН схем на Ga As із самосуміщеними нітридними та силіцидними затворами / С. П. Новосядлий, А. І. Терлецький, О. Б. Фрик // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – № 2. – С. 420–424.

9. **Новосядлий С. П.** Шляхи підвищення швидкодії Ga As-полових транзисторів Шотткі (ПТШ) та селективнолегованих гетеротранзисторів (СЛГТ) для формування сучасних НВЧ-схем / С. П. Новосядлий, І. М. Луцький // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – № 2. – С. 413–419.

10. **Novosyadly S. P.** Physical topological aspects of modelling gallium arsenide super beta transistors on heterostructures for speed integrated circuit of computer system / Novosyadly S. P., Melnyk L.V. // NATO Advanced Research Workshop Functional Nanomaterials and Devices for Electronics, Sensors, Energy Harvesting, 13-16 April, 2015, Lviv. – Lviv, 2015. – P. 19–20.

11. *Novosyadly S. P.* Local transistor isolation using oxidized porous silicon. // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем : матеріали XV Міжнар. конф. / *Novosyadly S. P.*, Wojko S. I. : у 2 т. – Івано-Франківськ : Голіней О. М., 2015. – Т. 2. – С. 195.

12. Modern problems of CAD topology speed VLSI structures / *Novosyadly S. P.*, Melnyk L.V., Varvaruk V.M., Novosyadly S.V., Marchuk S.M. // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем : матеріали XV Міжнар. конф. : у 2 т. – Івано-Франківськ : Голіней О.М., 2015. – Т. 2. – С. 242–243.

2014

13. Конструкторсько-технологічні аспекти формування структур сонячних елементів (СЕ) на кремнієвих епітаксійних структурах (КЕС) / *С. П. Новосядлий*, С. М. Марчук, В. М. Варварук, Л. В. Мельник // Фізика і хімія твердого тіла. – Івано-Франківськ, 2014. – Т.15, № 1. – С. 202–205.

14. *Новосядлий С. П.* Властивості структур і приладів на основі кремній та арсенідгалію на ізоляторі / *Новосядлий С. П.*, Мельник Л. В. // VI International Scientific-Practical Conference 'Physical and Technological Problems Of Radio Engineering Devices, Telecommunication, Nano-And Microelectronics, October 23-25, 2014, Chernivtsi. – Chernivtsi, 2014. – P. 19.

15. *Новосядлий С. П.* Вплив арсенідгалієвої технології на формування структур інтегральних схем / *Новосядлий С. П.*, Мельник Л. В. // Східно-Європейський журнал новітніх технологій. – 2014. – № 3/5 (69). – С. 25–31.

16. Спосіб травлення полі кремнію : заявка на винахід / *Новосядлий С.П.*, Мельник Л. В., Варварук В. М. / Прикарпатський національний університет. а201405259 від 19.05.14 р.

17. *Новосядлий С. П.*, Бережанський В.М., Мельник Л.В. Варварук В.М. Заявка на винахід. Спосіб іонно-плазмового планарного дифузійного джерела із нітриду бору. Прикарпатський національний університет. а201405290 від 19.05.14 р.

18. Конструкторсько-технологічні аспекти формування структур сонячних елементів (СУ) на кремнієвих епітаксійних структурах (КЕС) / *Новосядлий С. П.*, Марчук С. М., Варварук В. М., Мельник Л. В. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – № 1, Т.15. – С. 202–205.

19. Моделі напівізолюючих шарів арсеніду галію при їх формуванні багатозарядною іонною імплантацією / *С. П. Новосядлий* [та ін.] // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – № 4. – С. 872–878.

20. Новосядлий С. П. Особливості схемотехнічного та фізико-топологічного проектування аналогових інтегральних компараторів // Східно-Європейський журнал новітніх технологій. – 2014. – № 4/5 (70). – С. 4–15.

21. Пат. № 87386 Спосіб плазмохімічного травлення полікремнію / *Новосядлий С. П.*, Мельник Л.В., Варварук В.М., Кіндрат Т. П. ; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника». ; заяв. 10.02.2014 р.

22. **Новосядлий С. П.** Схемотехнічні, технологічні та фізико-топологічні методи підвищення швидкодії інтегральних компараторів // Східно-Європейський журнал новітніх технологій. – 2014. – № 5/5 (70). – С. 25–33.
23. **Новосядлий С. П.** Формування КМОН схем на GaAs із самосуміщеними нітридними та силіцидними затворами / **Новосядлий С. П.**, Терлецький А. І., Фрик О. Б. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – № 4, т. 15. – С. 420–424.

2013

24. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Аналогова і цифрова обробка сигналів» для студентів напряму підготовки «Комп'ютерна інженерія» / Голота В.І., **Новосядлий С. П.**, Когут І. Т., Фрик О. Б. ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, ВДВ ЦІТ. – Івано-Франківськ, 2013. – 103 с.
25. **Новосядлий С. П.** Адаптивні фільтри в цифровій обробці сигналів сучасних, телекомунікаційних систем / **Новосядлий С. П.**, Мельник Л. В., Новосядлий С. В. // Східно-Європейський журнал новітніх технологій. – 2013. – № 2/9 (62). – С. 48–55.
26. **Новосядлий С. П.** MATLAB в радіофізиці та електроніці : навч. посіб./ С. П. Новосядлий. – Івано-Франківськ : Сімик, 2013. – 248 с.
27. **Новосядлий С. П.** Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Техніка і електроніка НВЧ" для студентів напряму "Прикладна фізика" спеціальності "Радіофізика і електроніка" / С. П. Новосядлий, В. І. Мандзюк, Л. В. Мельник. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2013. – 55 с.
28. **Новосядлий С. П.** Особливості проектування слухових апаратів на інтегральній елементній базі / **Новосядлий С. П.**, Мельник Л. В. // Прикарпатський вісник НТШ. – 2013. – № 1 (17). – С. 220–237.
29. Пат. № 77223 МПК H01L21/00. Спосіб формування арсенід галієвих гетероепітаксійних структур для субмікронних НВЧ - великих інтегральних схем / Прикарпатський національний університет ; **Новосядлий С. П.**, Кіндрат Т. П., Мельник Л. В. Варварук В. М. ; заяв. 11.02.13. Бюл. № 3.
30. **Новосядлий С. П.** Техніка і електроніка НВЧ : навч. посіб. / С. П. Новосядлий, В. І. Мандзюк. – Івано-Франківськ : Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2013. – 524 с.
31. **Новосядлий С. П.** Технологія епітаксійного формування силіцидів для підвищення швидкодії ВІС / **Новосядлий С. П.**, Терлецький А. І., Фрик О. Б. // Матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., 24-26 жовтня 2013 р., Чернівці. – С. 167.
32. **Новосядлий С. П.** Фізико-технологічні аспекти багатозарядної імплантації арсенід галію в структурах приладів і схем / **Новосядлий С. П.**, Мельник Л. В., Кіндрат Т. П. // Східно-Європейський журнал новітніх технологій. – 2013. – № 5/5 (65). – С. 29–36.
33. Фізико-технологічні особливості формування металізації субмікронних GaAs - структур іонним фрезеруванням / **Новосядлий С. П.**, Мельник Л. В.,

Кіндрат Т. П., Варварук В. М. // Східно-Європейський журнал новітніх технологій. – 2013. – № 4/5(64). – С. 1–6.

34. Physical and Technological Features of the Formation of Submicron Metallization GaAsn Structures LSI ion Milling / *Novosyadly S.P.*, Kindrat T.R., Melnyk L.V., Varvaruk V.V., Voznyak Yu.V. // Materials XIV international conference Physics and Technology of thin Films and Nanosystems, May, 20-25, 2013 year, Ivano-Frankivsk. – Ivano-Frankivsk, 2013. – P. 143.

35. X-ray Diffractometry Diagnostic Technology Sub-Micron and Nano Structures LSI. Physical and Technological Features of the Formation of Submicron Metallization GaAsn Structures LSI ion Milling / *Novosyadly S.P.*, Kindrat T.R., Melnyk L.V., Varvaruk V.V. // Materials XIV international conference 'Physics and Technology of thin Films and Nanosystems', May, 20-25, 2013 year, Ivano-Frankivsk. – Ivano-Frankivsk, 2013. – P. 273.

2012

36. Дослідження ефективності гетерних технологій в структурах арсеніду галію / *С. П. Новосядлий*, С. М. Марчук, Ю. В. Возняк, Т. Р. Сорохтей // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – № 2. – С. 482–487.

37. Запужляк Р. І. Захист інформації в комп'ютерних системах: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності “Комп'ютерна інженерія” / Запужляк Р. І., *Новосядлий С. П.*, Головатий Т. В. // Прикарпатський національний університет. – Івано-Франківськ, 2012. – 34 с.

38. Аналогова і цифрова обробка сигналів : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму “Комп'ютерна інженерія” / *Новосядлий С. П.*, Когут І. Т., Голота В. І., Фрик О. Б. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету. – 2012. – 41 с.

39. *Новосядлий С. П.* Високоєфективні фотоелектричні перетворювачі сонячної енергії на основі бар'єра Шотткі до аморфного гідрогенізованого кремнію (а - Si : H) / С. П. Новосядлий, Л. В. Мельник // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – № 4. – С. 1071–1075.

40. Дослідження ефективності гетерних технологій в структурах GaAs / *Новосядлий С. П.*, Марчук С. М., Сорохтей Т. Р., Возняк Ю. В. // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т. 13, № 2. – С. 416–428.

41. Пат. № 68203 МПК H01L21/20. Спосіб формування епітаксійних арсенід-галієвих шарів на монокристалічних кремнієвих підкладках / *Новосядлий С. П.*, Вівчарук В. М., Кіндрат Т. П. ; Прикарпатський національний університет ; заяв. 26.03.12.

42. Пат. № 68204 МПК H01L21/00 від 26.03.12. Спосіб формування теплостійкої багат шарової металізації субмікронних структур ВІС / *Новосядлий С. П.*, Вівчарук В. М., Атаманюк Р. Б. ; Прикарпатський національний університет ; заяв. 26.03.12.

43. Пат. № 72058 МПК H01L21/00 від 10.08.12. Спосіб формування низькоомних контактів в субмікронних К-МОН-структурах ВІС / **Новосядлий С. П.**, Вівчарук В. М., Атаманюк Р. Б. ; Прикарпатський національний університет ; заяв.10.08.12.
44. Порівняльний аналіз сучасних кремнієвої і арсенідгалієвої субмікронних технологій формування структур швидкісних цифрових великих інтегральних схем / С. П. Новосядлий [та ін.] // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – № 3. – С. 808–815.
45. Спеціалізовані фоторезисти для сухої літографії / Новосядлий С. В., Варварук В. М., Мельник Л. В., Кіндрат Т. П. // Матеріали XVI Міжнародного молодіжного форуму “Радиоелектроника и молодежь в XXI веке”. – Харків – 2012. – Т. 3 – С. 72–73.
46. **Новосядлий С. П.** Структура, параметри, алгоритм адаптивних фільтрів в цифровій обробці сигналів в сучасних телекомунікаційних системах / Новосядлий С. П., Новосядлий С. В., Мельник Л. В. // Матеріали XVI Міжнародного молодіжного форуму “Радиоелектроника и молодежь в XXI веке”. – Харків, 2012. – Т. 4. – С. 86–87.
47. **Новосядлий С. П.** Технологічні особливості сухої вакуумної літографії для формування субмікронних структур ВІС / С. П. Новосядлий, Р. Б. Атаманюк, Т. Р. Сорохтей [та ін.] // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – № 1. – С. 273–278.

2011

48. **Новосядлий С. П.** Лабораторно-розрахунковий практикум з фізики напівпровідників та теорії твердого тіла / **Новосядлий С. П.**, Буджак Я. С., Мельник П. І. – Івано-Франківськ : Альт, 2011. – 240 с.
49. Методичні вказівки до виконання курсових та кваліфікаційних робіт і проектів для студентів спеціальності “Комп’ютерні системи та мережі” напряму “Комп’ютерна інженерія” / **Новосядлий С. П.**, Когут І. Т., Голота В. І., Мандзюк В. І. – Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет, ВДВ ЦІТ, 2011. – 67 с.
50. Моделі напівізолюючих арсенід-галієвих шарів при їх формуванні капсулюючою багатозарядною імплантацією / **Новосядлий С. П.**, Возняк Ю. В., Сорохтей Т. Р., Кіндрат Т. П., Марчук С. В. // Збірник тез V Української наукової конференції з фізики напівпровідників. – Ужгород. – 2011. – 327 с.
51. Особливості гетерної технології на GaAs-структурах / **Новосядлий С. П.**, Кіндрат Т. П., Возняк Ю. В., Сорохтей Т. Р., Марчук С. В. // Збірник тез V Української наукової конференції з фізики напівпровідників. – Ужгород. – 2011. – 328 с.
52. **Новосядлий С. П.** Основи радіоелектроніки. Нелінійні електричні кола і довгі лінії : навч. посіб. для ст. / **Новосядлий С. П.**, Онуфрик О. П. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету. – 2011. – 112 с.

53. Особливості гетерної технології на GaAs-структурах / **Новосядлий С. П.**, Кіндрат Т. П., Возняк Ю. В., Сорохтей Т. Р., Марчук С. В. // Збірник тез V Української наукової конференції з фізики напівпровідників. – Ужгород. – 2011. – 328 с.
54. **Новосядлий С. П.** Особливості формування SOI-структур для субмікронних ВІС з використанням багатозарядної іонної імплантації / **Новосядлий С. П.**, Вівчарук В. М., Сорохтей Т. Р. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2011. – № 3. – С. 30–43.
55. **Новосядлий С. П.** Спосіб планаризації металевої розводки субмікронних структур С. П. Новосядлий, В.М. Вівчарук // ВІС. – 2011. – № 22, 04234 від 07.04.2011.
56. **Новосядлий С. П.** Структура, параметри, алгоритм адаптивних фільтрів в цифровій обробці сигналів сучасних ІТС / **Новосядлий С. П.**, Мельник Л. В. // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Комп’ютерні системи. – 2011. – № 396.
57. **Новосядлий С. П.** Субмікронні шаруваті структури запам’ятовуючих пристроїв довільної вибірки з подвійним самосуміщенням для швидкодіючих комп’ютерних систем / **Новосядлий С. П.**, Кіндрат Т. П. // 5-а міжнародна конференція “Комп’ютерні системи і мережі: проектування і дослідження”. – Львів. – 2011.
58. Новосядлий С. П. Технологія високоефективних структур фотоелектричних приладів / С. П. Новосядлий. – Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2011. – 240 с.

2010

59. Атаманюк Р. Б. Аналіз сучасних безпроводних телекомунікаційних мереж зв’язку та методів підвищення їх швидкості / Атаманюк Р. Б., **Новосядлий С. П.** // Матеріали 4-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми телекомунікацій, 20-23 квітня 2010, Київ. – К., 2010. – С. 61.
60. Атаманюк Р. Б. Передача сигналів по волоконно-оптичних лініях / Атаманюк Р. Б., **Новосядлий С. П.** // Матеріали 4-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми телекомунікацій”, 20-23 квітня, 2010, Київ. – К., 2010. – С. 208.
61. **Новосядлий С. П.** Сигнальні графи як інструмент комп’ютерного моделювання термостабільності інтегральних гіраторів та проходження електромагнітного поля через межу середовищ / С. П. Новосядлий, С. М. Вертепний, В. П. Перегінський // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – № 3. – С.750–761.
62. **Новосядлий С. П.** Суб - і наномікронна технологія структур великих інтегральних схем : моногр. / С. П. Новосядлий. – Івано-Франківськ : "Місто-НВ", 2010. – 456 с.
63. **Новосядлий С. П.** Сучасні твердофазні технологічні аспекти в субмікронній технології ВІС / **Новосядлий С. П.**, Терлецький А. І., Фрик О.

Б. // Східно-Європейський журнал новітніх технологій. – 2010. – № 3/7 (45). – С. 52–60.

64. **Новосядлий С. П.** Сучасні твердофазні технологічні аспекти в субмікронній технології ВІС / **Новосядлий С. П.**, Терлецький А. І., Фрик О. Б. // Східно-Європейський журнал новітніх технологій. – 2010. – № 3/7 (45). – С. 52–60.

65. Температурна стабільність гідраторів на основі еквівалентів інтегральних транзисторних структур р-п-р-п-типу / **Новосядлий С. П.**, Вівчарук В. М., Атаманюк Р. Б., Перегінський В. П. // Фізика і хімія твердого тіла. – № 2. – 2010. – Т. 11. – С. 506–509.

66. **Новосядлий С. П.** Технологічні особливості осадження полікремнію, як основи сонячного і електронного моно кремнію / **Новосядлий С. П.**, Кропивич В. В. // Східно-європейський журнал новітніх технологій. – 2010. – № 3/7 (45). – С. 451–454.

67. **Новосядлий С. П.** Шляхи підвищення електрофізичних параметрів підзатворного діелектрика в субмікронних структурах / С. П. Новосядлий, В. М. Бережанський, В. М. Вівчарук // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – № 4. – С. 928–934.

68. Температурна стабільність гідраторів на основі еквівалентів інтегральних транзисторних структур р-п-р-п - типу / **С. П. Новосядлий**, В. М. Вівчарук, А. М. Атаманюк, В. П. Перегінський // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – № 2. – С. 506–509.

2009

69. Атаманюк Р. Б. Висококонтрастне проявлення та фізико-технологічні аспекти формування субмікронної топології великих інтегральних схем / Р. Б. Атаманюк, **С. П. Новосядлий** // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – № 1. – С. 205–214.

70. Бережанський В. М. Динамічне пірогенне осадження плівок діоксиду кремнію / В. М. Бережанський, **С. П. Новосядлий** // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем : матеріали XII міжнар. конф.: у 2 т. / [за заг. ред. Фреїка Д. М.]. – Івано-Франківськ, 2009. – Т. 1. – С. 211–212.

71. **Новосядлий С. П.** Електрофізичне діагностування надійності субмікронних структур ВІС за ефектами нелінійності їх характеристик / С. П. Новосядлий, О. Б. Фрик // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем : матеріали XII Міжнародної конференції : у 2 т. / [за заг. ред. Фреїка Д. М.]. – Івано-Франківськ, 2009. – Т. 2. – С. 399–400.

72. **Новосядлий С. П.** Конструкторно-технологічні особливості формування транзисторних структур ВІС для аналогово-цифрової схемотехніки / С. П. Новосядлий, В. М. Вівчарук, В. П. Перегінський // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – № 4. – С. 957–970.

73. **Новосядлий С. П.** Тестовий контроль технологічної САПР для діагностування рекомбінаційних процесів біполярних інтегральних схем

/ С. П. Новосядлий, С. М. Вертепний, М. В. Петрашук // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – № 2. – С. 440–446.

74. **Новосядлий С. П.** Технологічний процес формування Ga As-субмікронних структур / С. П. Новосядлий, Ю. В. Возняк // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем : матеріали XII міжнародної конференції: у 2 т. / [за заг. ред. Фреїка Д. М.]. – Івано-Франківськ, 2009. – Т. 1. – С. 263–264.

2008

75. **Новосядлий С. П.** Багатозарядна радикальна імплантація при формуванні SOI-структур / С. П. Новосядлий, В. М. Вівчарук // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – № 3. – С. 659–667.

76. **Новосядлий С. П.** Джерела іонів для формування шаруватих структур ВІС / С. П. Новосядлий, В. М. Бережанський // Прикарпатський вісник НТШ / [гол. ред. В. М. Мойсишин]. – Івано-Франківськ, 2008. – : Число, №1(1). – С. 151–159.

77. **Новосядлий С. П.** Електрофізичне діагностування надійності субмікронних структур великих інтегральних схем за ефектами нелінійності їх характеристик / С. П. Новосядлий, О. Б. Фрик // Прикарпатський вісник НТШ / [гол. ред. В. М. Мойсишин]. – Івано-Франківськ, 2008. – Число, № 1(1). – С. 182–191.

78. **Новосядлий С. П.** Техніко-економічний аналіз субмікронної технології формування структур великих інтегральних схем / С. П. Новосядлий, О. Б. Фрик // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – № 4. – С. 883–886.

2007

79. Атаманюк Р. Б. Мінімізація алгоритмічного процесу проектування інтегральних схем методом кремнієвої компіляції за часово-ймовірнісним критерієм / Р. Б. Атаманюк, **С. П. Новосядлий** // Вісник Прикарпатського університету. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. III. – С. 84–89.

80. Буджак Я. С. Лабораторно-розрахунковий практикум з фізики напівпровідників та теорії твердого тіла : навч. посіб. / Я. С. Буджак, П. І. Мельник, **С. П. Новосядлий**. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2007. – 233 с.

81. **Новосядлий С. П.** Дослідження і моделювання теплових процесів в потужних ІС / С. П. Новосядлий, Р. М. Іванюк // Фізика і хімія твердого тіла. – Івано-Франківськ, 2007. – Т. 8., № 1. – С. 196–202.

82. **Новосядлий С. П.** Основи радіоелектроніки. Перехідні процеси в електричних колах : метод. рекомендації для студентів спеціальності "Радіофізика і електроніка" / С. П. Новосядлий, О. П. Онуфрик. – Івано-Франківськ : Плай, 2007. – 56 с.

83. **Новосядлий С. П.** Підвищення теплостійкості і багатошарової металізації субмікронних структур ВІС / С. П. Новосядлий, Р. М. Іванюк // Фізика і хімія твердого тіла. – 2007. – № 4. – С.850–855.
84. **Новосядлий С. П.** Техніка і електроніка НВЧ : лабораторний практикум / С. П. Новосядлий, В. І. Голота, В. І. Мандзюк. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2007. – 116 с.
85. Спектрометрія в субмікронній технології ВІС / П. І. Мельник, **С. П. Новосядлий**, В. М. Бережанський, В. М. Вівчарук // Фізика і хімія твердого тіла. – 2007. – № 4. – С.791–800.